رطو

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出題公開番号 特開2003-243164 (P2003-243164A)

(43)公開日 平成15年8月29日(2003.8.29)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマ	1-1 (多考)	
H05B	33/10		H05B	33/10		2	C162	
B41J	2/44			33/14		A 3	K007	
	2/45		B41J	3/21		L		
	2/455							
H05B	33/14							
			審査請求	未請求	請求項の数4	OL	(全 8 頁)	
(21)出願番号	<b>,</b>	特顧2002-38764(P2002-38764)	(71)出願	(71)出願人 500171707				
					会社プイ・テクノ			
(22)出顧日		平成14年2月15日(2002.2.15)		神奈	川県厚木市岡田3	050番地		
			(72)発明	者 梶山	康一			

(74)代理人 100080528 弁理士 下山 富士男 Fターム(参考) 2C162 AE28 AE47 AG05 FA04 FA16 FA23 FA34

イ・テクノロジー内

3K007 AB18 DB03 FA01

神奈川県厚木市岡田3050番地 株式会社ブ

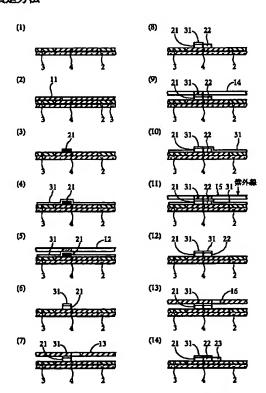
#### (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【課題】R, G, B各セグメントを剥離のおそれなく確実に形成することができる有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法を提供する。

【解決手段】透明導電膜3、陽極4が形成されたガラス基板2に対してマスク板によりRセグメント部発光層21を塗布する工程と、ガラス基板2の全面に撥水性フッ素コーティング31を施す工程と、ガラス基板2上のRセグメント以外の部分の撥水性フッ素コーティング31を除去する工程と、R、G各セグメント以外の部分の撥水性フッ素コーティング31を除する工程と、ガラス基板の全面に撥水性フッ素コーティング31を施す工程と、R、G各セグメント部分をマスクしてBセグメント発光層23を塗布する工程と、R、G、B各セグメント以外の部分の撥水性フッ素コーティング31を除去する工程と、R、G、B各セグメント以外の部分の撥水性フッ素コーティング31を除去する工程と有するものである。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】導電膜、電極が形成された基板に対してマスク板によるマスクをしてRセグメント部を形成する発光層を塗布する工程と、

基板の全面に撥水性の剥離防止層を施す工程と、

基板上のRセグメント部分をマスクしてそれ以外の部分 の撥水性の剥離防止層を除去する工程と、

Rセグメント部分をマスクしてGセグメントを形成する 発光層を塗布する工程と、

R, G各セグメント部分をマスクしてそれ以外の部分の 接水性の剥離防止層を除去する工程と、

基板の全面に撥水性の剥離防止層を施す工程と、

R, G各セグメント部分をマスクしてBセグメントを形成する発光層を塗布する工程と、

R, G, B各セグメント部分をマスクしてそれ以外の部分の撥水性の剥離防止層を除去する工程と、

を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス ス酸光装置の製造方法。

【請求項2】導電膜、電極が形成された基板に対してマスク板によるマスクをしてRセグメント部を形成する発光層を塗布する工程と、

基板の全面に撥水性フッ素コーティングを施す工程と、 基板上のRセグメント部分をマスクして紫外線でそれ以 外の部分の撥水性フッ素コーティングを劣化して除去す る工程と、

Rセグメント部分をマスクしてGセグメントを形成する 発光層を塗布する工程と、

R, G各セグメント部分をマスクして紫外線でそれ以外 の部分の撥水性フッ素コーティングを劣化して除去する 工程と、

基板の全面に撥水性フッ素コーティングを施す工程と、 R, G各セグメント部分をマスクしてBセグメントを形成する発光層を塗布する工程と、

R, G, B各セグメント部分をマスクして紫外線でそれ 以外の部分の撥水性フッ素コーティングを劣化して除去 する工程と、

【請求項3】基板上に陽極電極膜を形成する工程と、 陽極電極膜上にRセグメント部を形成する有機EL材を 塗布する工程と、

基板上のRセグメント部分を形成する有機EL材をマスクしてそれ以外の部分の有機EL材を除去する工程と、 基板の全面に撥水膜を塗布する工程と、

基板上のRセグメント部分を形成する有機EL材上の撥 水膜をマスクしてそれ以外の部分の撥水膜を除去する工 程と、

撥水膜が除去され陽極電極膜が露出した領域にGセグメント部を形成する有機EL材及び撥水膜を塗布する工程と、

必要なGセグメント部上の撥水膜をマスクしてそれ以外 の部分のGセグメント部及び撥水膜を除去する工程と、 撥水膜が除去され陽極電極膜が露出した領域にBセグメ ント部を形成する有機EL材及び撥水膜を塗布する工程 と、

必要なGセグメント部上の撥水膜をマスクしてそれ以外 の部分のGセグメント部及び撥水膜を除去する工程と、 R, G, B各セグメント部分の上部に陰極電極膜を形成 する工程と、

を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法。

【請求項4】前記R, G, Bセグメント部分を形成する 有機EL材を塗布する工程には、有機EL材上へのアク ティベーション膜の塗布工程も含まれることを特徴とす る請求項3記載の有機エレクトロルミネッセンス露光装 置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法に関するものである。 【従来の技術】従来、フラットパネルディスプレイとしては通常液晶ディスプレイが使われているが、最近、密閉された環境下でモノマーを蒸着したり、或いは高分子を塗ることによって作られる自発光性の有機乱露光装置が使用されるようになってきている。モノマーを利用したものは、ガラスを適切な形状のマスクで覆い、単分子膜を蒸著して作製される。このとき、モノマーは容易に剥がれる欠点がある。また、最近、高分子を利用する高分子有機EL露光装置が創作されている。この場合は、高分子であるため、パターニングは不可能であるので、ガラスに高分子を塗ってから機械的に切断して作製する

【発明が解決しようとする課題】通常、液晶ディスプレ イでは、R、G、B各セグメントを順次蒸着していく が、低分子蒸着膜、高分子塗布の場合は、蒸着に使用さ れる物質がいずれも水に弱く(化学反応して、膜が破壊 されたり、不透明になる)、空気中の水蒸気によって、 反応が起こるので通常行われるR、G、Bを蒸着又は塗 布しそれに現像液をかけ露光し現像する操作は不可能で ある。そこで、超高真空下、若しくは密封条件下の乾燥 した環境下で蒸着又は塗布することになる。このとき、 通常のように、マスクを替えて、R、G、B各セグメン トを順次蒸着又は塗布することは困難である。また、有 機EL露光装置を動画、静止画の表示装置とするために は、塗布したR、G、B (赤、緑、青) の各EL層をパ ターニングする必要があるが、パターニングする最も一 般的で生産性の高い方法は、半導体や液晶の分野で使用 されている露光プロセスである。しかし、現状の露光プ ロセスはウェット方式がほとんどである。従って、空気 中の水蒸気すら嫌う有機EL材料にウェットの露光を適 用することはできない。この事が有機EL表示装置の量 産に関して大きな障害になっている。一方、ウェット露 光方式の代わりに、ドライ露光のプロセスを使用するこ とも考えられが、ドライ露光プロセスは基本的にポジ型 であるためにR、G、B各層をパターン化できないとい う問題がある。図14乃至図18に従来の有機エレクト ロルミネッセンス露光装置の製造方法の一例を示す。ま ず、ガラス基板101上にITO電極膜102を蒸着し (図14)、次にITO電極膜102上にRセグメント 部を形成するための有機EL材111を塗布する(図1 5)。次に、マスク103を使用し紫外線(UV)照射 による露光を行いRセグメント部のパターン化を実施す る(図16)。これにより、マスクに遮光されない有機 EL材は光分解して消失する。次に、ガラス基板101 上にGセグメント部を形成するための有機EL材112 を塗布する (図17)。この状態で、紫外線 (UV) 照 射をして、Gセグメント部を形成する有機EL材112 をパターン化しようとしても、Rセグメント部を形成す る有機EL材111を残そうとすると、有機EL材11 1上に有機EL材112が残ってしまう(図18)。又 は、有機EL材111の上の有機EL材112に紫外線 を照射すると、有機EL材111も消失し又はダメージ を受けてしまう。このように、単純なドライプロセスは 有機EL材のパターン化には適用できない。また、前記 有機EL材111の上に前記有機EL材112が塗布さ れ重なると、有機EL材111の発光が成立しなくな り、有機エレクトロルミネッセンス露光装置としての意 味をなさないので、上述したような重なりを防ぐ工夫が 必要となる。本発明は、上記従来の事情に鑑みて開発さ れたものであり、R, G, B各セグメントを剥離のおそ れなく確実に形成することができ、また、ドライプロセ スでR、G、B各層のパターン化も確実に実現できる有 機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法を提供 することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明に係 る有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法 は、導電膜、電極が形成された基板に対してマスク板に よるマスクをしてRセグメント部を形成する発光層を塗 布する工程と、基板の全面に撥水性の剥離防止層を施す 工程と、基板上のRセグメント部分をマスクしてそれ以 外の部分の撥水性の剥離防止層を除去する工程と、Rセ グメント部分をマスクしてGセグメントを形成する発光 層を塗布する工程と、R、G各セグメント部分をマスク してそれ以外の部分の撥水性の剥離防止層を除去する工 程と、基板の全面に撥水性の剥離防止層を施す工程と、 R、G各セグメント部分をマスクしてBセグメントを形 成する発光層を塗布する工程と、R,G,B各セグメン ト部分をマスクしてそれ以外の部分の撥水性の剥離防止 層を除去する工程と有することを特徴とするものであ る。請求項2記載の発明に係る有機エレクトロルミネッ センス露光装置の製造方法は、導電膜、電極が形成され た基板に対してマスク板によるマスクをしてRセグメン ト部を形成する発光層を塗布する工程と、基板の全面に 撥水性フッ素コーティングを施す工程と、基板上のRセ グメント部分をマスクして紫外線でそれ以外の部分の撥 水性フッ素コーティングを劣化して除去する工程と、R セグメント部分をマスクしてGセグメントを形成する発 光層を塗布する工程と、R、G各セグメント部分をマス クして紫外線でそれ以外の部分の撥水性フッ素コーティ ングを劣化して除去する工程と、基板の全面に撥水性フ ッ素コーティングを施す工程と、R、G各セグメント部 分をマスクしてBセグメントを形成する発光層を塗布す る工程と、R, G, B各セグメント部分をマスクして紫 外線でそれ以外の部分の撥水性フッ素コーティングを劣 化して除去する工程とを有することを特徴とするもので ある。このような請求項1、2記載の発明によれば、 R, G, B各セグメント部分を構成する発光層の順次の 塗布と、剥離防止層である撥水性フッ素コーティングの 形成及び不要部分の除去とを組み合わせることにより、 導電膜、電極が形成された基板上にR, G, B各セグメ ントを剥離のおそれなく確実に形成することができる。 請求項3記載の発明に係る有機エレクトロルミネッセン ス露光装置の製造方法は、基板上に陽極電極膜を形成す る工程と、陽極電極膜上にRセグメント部を形成する有 機EL材を塗布する工程と、基板上のRセグメント部分 を形成する有機EL材をマスクしてそれ以外の部分の有 機EL材を除去する工程と、基板の全面に撥水膜を塗布 する工程と、基板上のRセグメント部分を形成する有機 EL材上の撥水膜をマスクしてそれ以外の部分の撥水膜 を除去する工程と、撥水膜が除去され陽極電極膜が露出 した領域にGセグメント部を形成する有機EL材及び撥 水膜を塗布する工程と、必要なGセグメント部上の撥水 膜をマスクしてそれ以外の部分のGセグメント部及び撥 水膜を除去する工程と、撥水膜が除去され陽極電極膜が 露出した領域にBセグメント部を形成する有機EL材及 び撥水膜を塗布する工程と、必要なGセグメント部上の 撥水膜をマスクしてそれ以外の部分のGセグメント部及 び撥水膜を除去する工程と、R, G, B各セグメント部 分の上部に陰極電極膜を形成する工程とを有することを 特徴とするものである。請求項4記載の発明は、請求項 3記載の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造 方法において、前記R、G、Bセグメント部分を形成す る有機EL材を塗布する各工程には、有機EL材上への アクティベーション膜の塗布工程も含まれることを特徴 とするものである。このような請求項3、4記載の発明 によれば、ドライプロセスで、有機EL材、撥水膜の塗 布、マスクを使用した紫外線照射の組み合わせによっ て、R, G, B各セグメント部を形成する有機EL材が 重なり合うことのないパターン化を確実に実現すること ができる。

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る有機エレクト

ロルミネッセンス露光装置の製造方法の実施の形態を図面を参照して詳述する。

(実施の形態1) 図1は、本発明の実施の形態1の有機 エレクトロルミネッセンス露光装置を示す概略断面図で あるこの有機エレクトロルミネッセンス露光装置1は、 ガラス基板2、透明導電膜(ITO)3、陽極4、発光 屬5、陰極6、保護層7、保護基板8により概略構成さ れる。次に、本発明の実施の形態1の有機エレクトロル ミネッセンス露光装置1の製造方法について図2を参照 して説明する。まず、図2(1)に示すように、透明導 電膜3、陽極4が形成されたガラス基板2を用意し、ガ ラス基板2に対して図2(2)に示すように、マスク板 11によるマスクをしてRセグメント部を形成する発光 層21を塗布する。発光層21が塗布された状態を図2 (3) に示す。次に、図2(4) に示すように、ガラス 基板2の全面に剥離防止層である撥水性フッ素コーティ ング31を施す。次に、図2(5)に示すように、ガラ ス基板 2 上の R セグメント部分をマスク板 1 2 によりマ スクして、紫外線を照射して、それ以外の部分の撥水性 フッ素コーティング31を劣化して除去する。紫外線を 照射して、それ以外の部分の撥水性フッ素コーティング 31を除去した状態を図2(6)に示す。次に、図2 (7) に示すように、Rセグメント部分をマスク板13 によりマスクしてGセグメント部分を形成する発光層2 2を塗布する。発光層22を塗布したときの状態を図2 (8) に示す。次に、図2(9) 示すように、R, Gセ グメント部分をマスク板14によりマスクしてガラス基 板2の全面に撥水性フッ素コーティング31を施す。撥 水性フッ素コーティング31を施した状態を図2(1 0) に示す。次に、図2(11)に示すように、ガラス 基板2上のRセグメント部分、Gセグメント部分をマス ク板15によりマスクして、紫外線を照射して、それ以 外の部分の撥水性フッ素コーティング31を劣化して除 去する。撥水性フッ素コーティング31を除去した状態 を図2(12)に示す。次に、図2(13)に示すよう に、Rセグント、Gセグメント部分をマスク板16によ りマスクしてBセグメントを形成する発光層23を塗布 する。発光層23を塗布したときの状態を図2(14) に示す。本実施の形態1に係る有機エレクトロルミネッ センス露光装置の製造方法によれば、ガラス基板2上 に、発光層5を構成することになるR, G, Bセグメン ト部分を形成する発光層21,22,23を互いに重な り合うことなく、且つ、剥離の惧れなく確実に形成する ことができる。この後、陰極6、保護層7、保護基板8 を順次積層して有機エレクトロルミネッセンス露光装置 1とするものである。

(実施の形態2) 次に、本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置50の製造方法について図3万至図13を参照して説明する。本実施の形態2の製造方法は、まず、基板(ガラス基板)60上に陽極

電極膜(ITO膜) 61を蒸着する(図3)。次に、陽 極電極膜61上にRセグメント部を形成する有機EL材 51を塗布する(図4)。次に、必要なRセグメント部 を形成する有機EL材51の部分をマスク (フォトマス ク) 71によりマスクし、紫外線(UV) 照射による露 光を行い、遮光されない有機EL材51を光分解して消 失させ、Rセグメント部のパターン化を行う(図5)。 更に、パターン化されたRセグメント部へアクティベー ション膜を塗布する。次に、パターン化されたRセグメ ント部を形成する有機EL材51上及び陽極電極膜61 上に撥水膜(撥水、撥油等濡れ性の微小な膜)54を塗 布した後、マスク71によりマスクし、紫外線(UV) 照射による露光を行い(図6)、遮光されない撥水膜5 4を光分解して消失させて必要なRセグメント部を形成 する有機EL材51及びその上の撥水膜54を残存さ せ、他の部分は陽極電極膜61が露出した状態とする (図7)。次に、陽極電極膜61が露出した部分にGセ グメント部を形成する有機EL材52を塗布し、更に図 示しないアクティベーション膜を塗布し、更にその上に 撥水膜54を塗布する(図8)。次に、必要なGセグメ ント部を形成する有機EL材52の部分をマスク(フォ トマスク)72によりマスクし、紫外線(UV)照射に よる露光を行い、遮光されない有機EL材52を光分解 して消失させ、その部分に陽極電極膜61が露出した状 態としてGセグメント部のパターン化を行う(図9)。 次に、陽極電極膜61が露出した部分にBセグメント部 を形成する有機EL材53を塗布し、更に図示しないア クティベーション膜を塗布し、更にその上に撥水膜54 を塗布する(図10)。次に、必要なBセグメント部を 形成する有機EL材53の部分をマスク(フォトマス ク) 73によりマスクし、紫外線(UV) 照射による露 光を行い、遮光されない有機EL材53を光分解して消 失させ、その部分に陽極電極膜61が露出した状態とし てGセグメント部のパターン化を行う(図11)。この ようにして、図12に示すように、基板60上に、R、 G、B各セグメント部を形成する有機EL材51、5 2、53をパターン化した状態で形成する(図12)。 この後、図13に示すように、有機EL材51、52、 53上に陰極電極膜62を形成し、更に、陽極電極膜6 1、陰極電極膜62に電源部80を接続することで、本 実施の形態2に係る有機エレクトロルミネッセンス露光 装置50を得る。

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、R,G,B各セグメント部分を構成する発光層の順次の塗布と、剥離防止層である撥水性フッ素コーティングの形成、及び不要部分の除去とを組み合わせることにより、導電膜、電極が形成された基板上にR,G,B各セグメントを剥離のおそれなく確実に形成することができる有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法を提供することができる。また、本発明によれば、ドライプロセス

で、且つ、有機EL材、撥水膜の塗布、マスクを使用した紫外線照射の組み合わせによって、R, G, B各セグメント部を形成する有機EL材が重なり合うことのないパターン化を確実に実現することができる有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造方法を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1の有機エレクトロルミネッセンス露光装置を示す概略断面図である。

【図2】本発明の実施の形態1の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程を示す工程図である。

【図3】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(陽極電極膜塗布)を示す工程図である。

【図4】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(有機EL材)を示す工程図である。

【図5】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(露光によるパターン化)を示す工程図である。

【図6】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(撥水膜露光)を示す工程図である。

【図7】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(Rセグメント用EL材パターン終了)を示す工程図である。

【図8】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(Gセグメント用EL材塗布)を示す工程図である。

【図9】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス解光装置の製造工程(Gセグメント用EL材露光)を示す工程図である。

【図10】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(Bセグメント用EL材 塗布)を示す工程図である。

【図11】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(Bセグメント用EL材露光)を示す工程図である。

【図12】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置のEL材のパタニング終了状態を示す断面図である。

【図13】本発明の実施の形態2の有機エレクトロルミネッセンス露光装置を示す概略断面図である。

【図14】従来の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(陽極電極膜塗布)を示す工程図である。

【図15】従来の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(有機EL材塗布)を示す工程図である。

【図16】従来の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(露光によるパターン化)を示す工程図である。

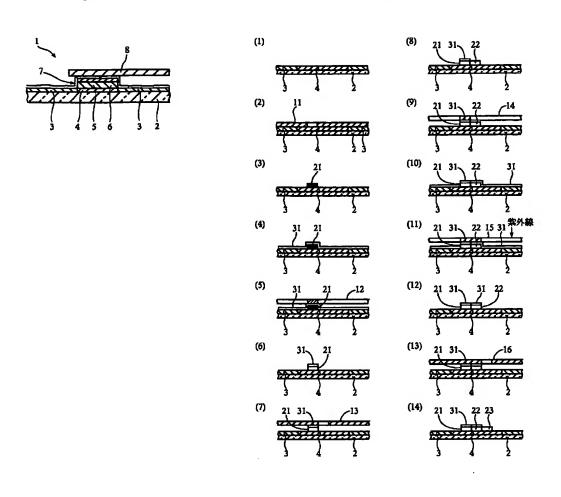
【図17】従来の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程(2色目の有機EL材塗布)を示す工程図である。

【図18】従来の有機エレクトロルミネッセンス露光装置の製造工程における有機EL材の重なりを示す断面図である。

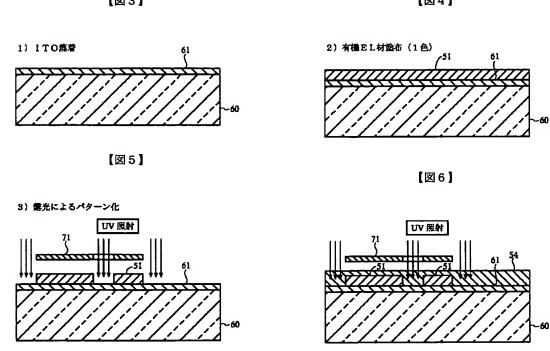
#### 【符号の説明】

- 1 有機エレクトロルミネッセンス露光装置
- 2 ガラス基板
- 3 透明導電膜
- 4 陽極
- 5 発光層
  - 6 陰極
  - 7 保護層
  - 8 保護基板
  - 11 マスク板
  - 12 マスク板
  - 13 マスク板
  - 14 マスク板
  - 15 マスク板
  - 16 マスク板17 マスク板
  - 21 発光層
  - 22 発光層
  - 23 発光層
  - 31 撥水性フッ素コーティング
  - 50 有機エレクトロルミネッセンス露光装置
  - 51 有機EL材
  - 52 有機EL材
  - 53 有機EL材
  - 5 4 撥水膜
  - 60 基板
  - 61 陽極電極膜
  - 62 陰極電極膜
  - 80 電源部

[図1] 【図2】

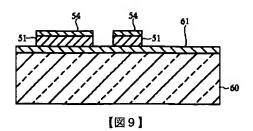


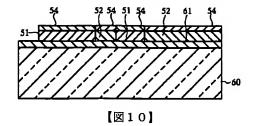


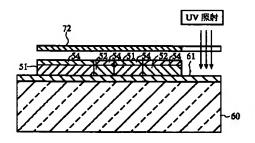


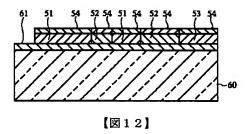
【図7】

【図8】

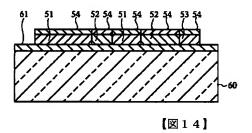


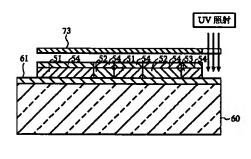


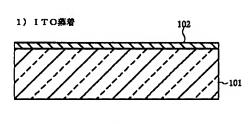






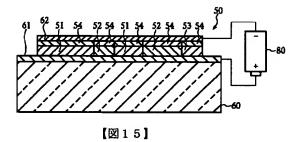


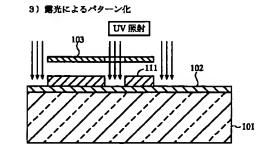


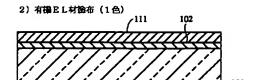


【図13】



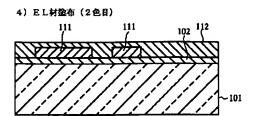


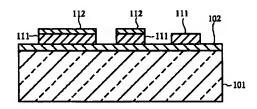




[図17]

【図18】





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
OTHER:				

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.